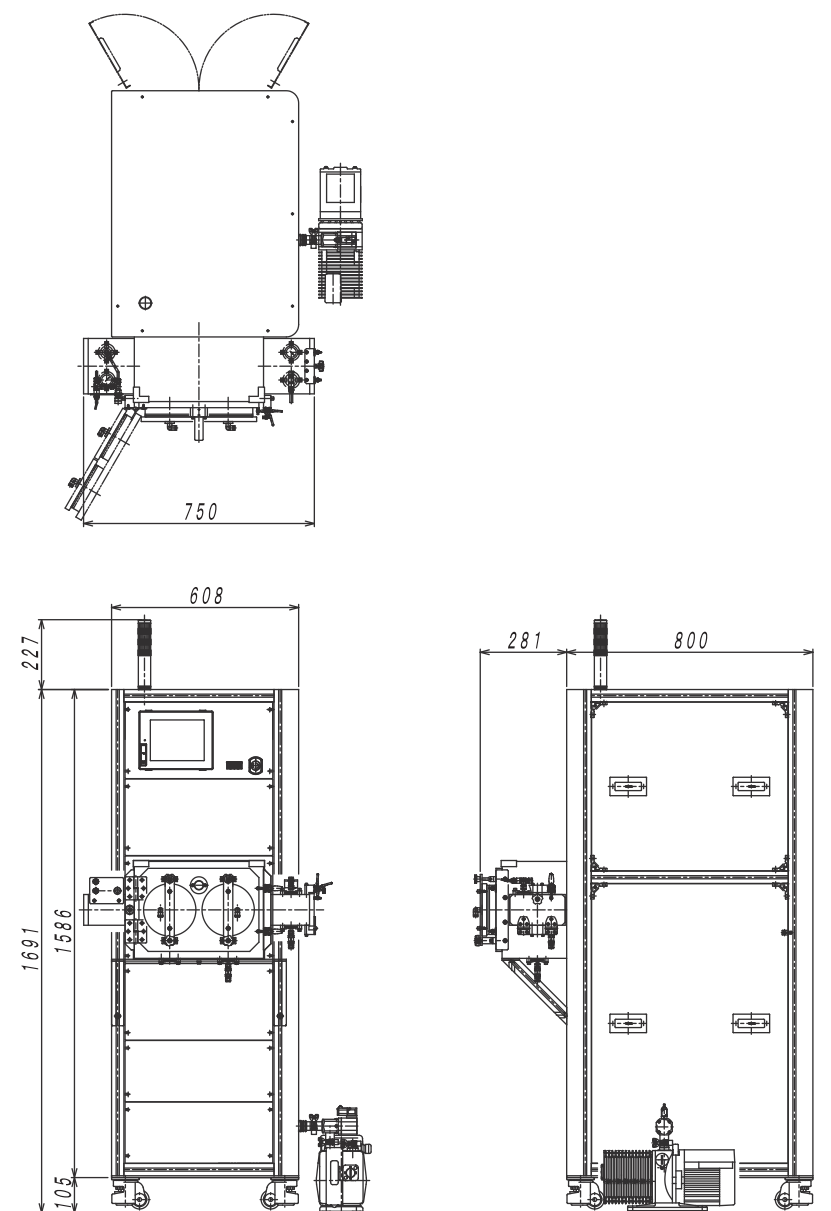




本体寸法 (mm) : W750×D1081×H1918

SSP Plus Series

SSP2500G

グローブボックス付きスパッタ装置

Sputtering Equipment with Glove Box



株式会社菅製作所

本社 〒049-0101 北海道北斗市追分3-2-2
札幌オフィス 〒060-0012 北海道札幌市中央区北12条西16-1-5-211
静岡オフィス 〒412-0042 静岡県御殿場市萩原761-1-202

全共通 TEL. 050-3734-0730
URL : <https://www.agus.co.jp>



* 製品向上等のため予告なく仕様を変更することがあります。
* 輸出に関する注意事項 : 本カタログに掲載しています製品を日本国外に輸出する際は、
外国為替及び外国貿易法の規定に基づく判定が必要となりますので、弊社営業部門に
必ずお問い合わせください。

SUGA Co., Ltd.

Head office: 3-2-2, Oiwake, Hokuto-shi, Hokkaido, 049-0101, Japan
Branch offices: Sapporo, Shizuoka

TEL. +81-50-3734-0730
URL : <https://www.agus.co.jp/en/>



* Product specifications are subject to change without notice.
* Notice of Export Control : In the event that any product described or contained herein
falls under the category of strategic products controlled by the Foreign Exchange and
Foreign Trade Control Law of Japan, exporting of such products shall require an export
license from the Japanese government in accordance with the above law.

グローブボックス付きスパッタ装置

SSP2500G

Sputtering Equipment with Glove Box

SSP2500G グローブボックス付きスパッタ装置は、不活性ガス雰囲気中で基板交換およびターゲット交換ができる、高品質と低価格を実現した研究開発用小型スパッタ装置です。

小型ながら 2 インチカソードを 2 基備え、真空を破らずにターゲット基板間の距離を変えることが可能で、基板を加熱しながら回転成膜することができます。また、前面ハッチと基板チャッキング機構により、容易に基板交換ができる構造としています。

スパッタチャンバー前面ハッチ部に真空置換可能なパスボックス付き簡易グローブボックスを直結しているため、大気に曝さずに基板交換、ターゲット交換が可能です。

● 特 徴

－ 多様性 －

- ・ 真空置換可能な簡易グローブボックス（アクリル樹脂製）を装備していますので、大気中の水分や酸素に曝さずに、基板の交換およびターゲットの脱着が可能です。
- ・ オプションのカソードマグネット交換により、磁性体ターゲットにも対応可能です。
- ・ プロセスガスは最大 3 系統まで増設することが可能です。

－ 性能 －

- ・ 基板φ100mm エリアで成膜分布 ±5％以下を実現します。
- ・ R F 電源を標準採用しているため、絶縁ターゲットも成膜可能です。
- ・ 基板ホルダーは真空中でも自動回転上下駆動が可能です。（ターゲットと基板間距離 60～95mm 可変）
- ・ 2 インチカソードを 2 基標準装備しており、積層成膜とターゲット直上の静止成膜が可能です。

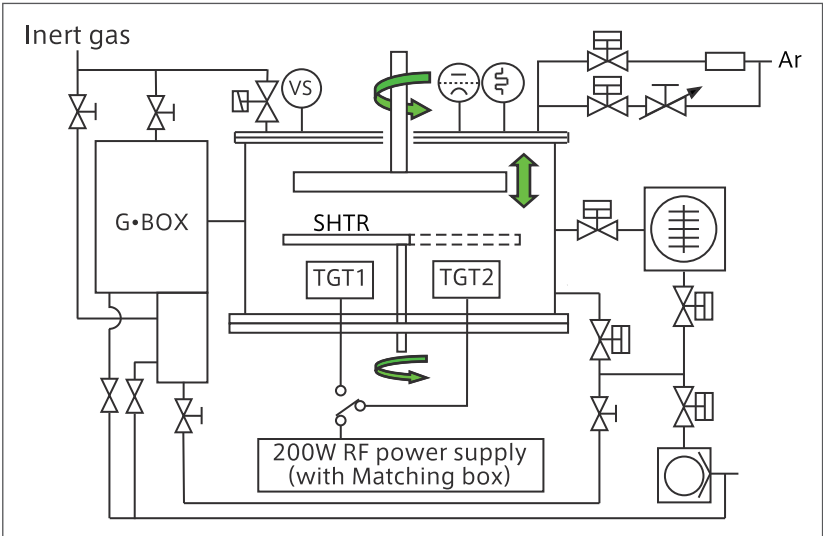
－ 使い易さ －

- ・ 小さな省フットプリント装置です。
- ・ タッチパネルで成膜プロセスのレシピ設定や各駆動機器の動作確認が行えます。
- ・ チャンバー内部防着シールド板と覗き窓（シャッター、シールドガラス付き）を装備しています。

－ 安全性 －

- ・ 各種インターロックにより、安全性の高い装置となっています。
- ・ 装置前面ハッチと自動チャッキング機構により、基板専用トレイを容易に出し入れできます。
- ・ 装置筐体内を負圧にする排気ダクトホースアダプターを装備しています。（ダクトはお客様接続）

● 基本ブロックダイアグラム



性能 Performance			
真空性能 Vacuum performance	到達圧力 Vacuum pressure	≦ 9×10 ⁻⁵ Pa	
成膜性能 Deposition performance	膜厚分布 Uniformity	回転成膜 Substrate rotation	φ100mm area ≦±5%

仕様 Specification		標準オプション Standard option
スパッタ方向 Direction of sputtering		スパッタアップ Depo up
カソード Cathode		φ2” PMC (Planar Magnetron Cathode) ×2基 φ2” PMC (Planar Magnetron Cathode) 2 pieces
ターゲット Target		非磁性材料 φ50.8mm×t3mm Non-magnetic target φ50.8mm×t3mm
基板ホルダー Substrate holder	ホルダーサイズ Holder size	φ140mm
	基板サイズ Substrate size	φ100mmMAX または 不定形基板 (取付板付き) φ100mmMAX or indeterminate form
	基板加熱ヒーター温度 Temperature rating of substrate heater	300℃MAX
	回転機構 Rotation	自動2rpm Automatic 2rpm
	上下機構 Elevation	自動ストローク35mm Automatic stroke 35mm
	チャッキング機構 Substrate chuck	自動駆動 Automatic drive
カソードシャッター Cathodal shutter		回転シャッター Rotary shutter
ターゲット基板間距離 Distance between target and substrate		60～95mm自動上下制御 60～95mm/Automatic control
排気系 Vacuum pump	主ポンプ Main pump	ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump
	補助ポンプ Backing pump	油回転真空ポンプ Rotary vane pump
各種バルブ Valves		自動駆動 Automatic drive
ガス導入系 Process gas		Arマスフローコントローラ1系統 Ar mass flow controller/1 line
スパッタ電源 Sputtering power supply	高周波電源 RF power supply	200W RF電源 (自動整合器付き) 200W RF power supply (With automatic matching box)
制御方法 Control system		タッチパネル Touchpad control
質量 Mass	装置本体：250kg, 油回転真空ポンプ：10kg Main unit：250kg, Rotary vane pump：10kg	
その他 Others	自動カソード切替器 Automatic cathode changer	
		逆スパッタ機構 Reverse sputtering mechanism

ユーティリティー Utility					
電力・接地 Electric power	電力 Power	3φ 200V±10% 30A 50/60Hz	圧縮空気 Air	供給圧力 Pressure supply	0.5～0.8MPa
	接地 Ground	D種接地 GND for below 100Ω		供給口 Connect	Rc1/8
	入力ケーブル Input cable	ケーブル長5m (装置添付) お客様接続側：M5用圧着端子 Length 5m (appendant parts) Cable terminal on user side: M5 solderless terminals	プロセスガス (Arガス) Process gas (Ar gas)	供給圧力 Pressure supply	0.1MPa
冷却水 Coolant			パージガス (不活性ガス) Purges gas (Inert gas)	供給口 Connect	1/4Swagelok
	水量 Water flow rate	≧ 3L/min		供給圧力 Pressure supply	0.1～0.3MPa
	供給圧 Pressure supply	0.2～0.3MPa (Back pressure ≦0.05MPa)		供給口 Connect	1/4Swagelok
	水温 Temperature	15～30℃			
	接続口 Connect	Rc3/8			